

Сведения о ведущей организации по диссертации  
**Майбороды Ивана Олеговича**  
**«Механизмы формирования высокотемпературных слоев AlN и AlGaN в аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии»,**  
представленной на соискание ученой степени  
кандидата физико-математических наук  
по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Элма-Малахит»   |
| Сокращенное наименование        | АО «Элма-Малахит»   |
| Веб-сайт                        | <a href="http://elma-malachit.ru">http://elma-malachit.ru</a>                               |
| Почтовый адрес с индексом       | 124460 Москва, Зеленоград,<br>проспект Панфиловский, дом 10,<br>пом. 327, этаж 2, комн. 39Г |
| Телефон                         | +7(499) 732-18-30   |
| Адрес электронной почты         | <a href="mailto:info@elma-malahit.ru">info@elma-malahit.ru</a>                              |

Список основных публикаций работников организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет:

1. Тарасова Е.А., Хананова А.В., Оболенский С.В., Земляков В.Е., Свешников Ю.Н., Егоркин В.И., Иванов В.А., Медведев Г.В., Смотровин Д.С. Исследование распределения электронов в GaN и GaAs структурах после ГАММА-нейтронного облучения // Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50. № 3. С. 331-338.
2. Арендаренко А.А., Орешкин В.А., Свешников Ю.Н., Цыпленков И.Н. Тенденции развития эпитаксиальной технологии нитридных соединений // Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. 2015. Т. 18. № 1 (69). С. 5-15.
3. Chernykh A.V., Chernykh S.V., Didenko S.I., Baryshnikov F.M., Britvich G.I., Kostin M.Yu., Chubenko A.P., Guly V.G., Sveshnikov Yu.N., Burtebayev N., Burtebayeva J.T., Koltsov G.I. Fast neutron detector based on surface-barrier VPE GaAs structures // Journal of Instrumentation. 2015. Т. 10. № 1. С. C01021.
4. Red'ko R.A., Konakova R.V., Milenin V.V., Red'ko S.M., Shvalagin V.V., Sveshnikov Y.N. Long-term transformation of GaN/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> defect subsystem induced by weak magnetic fields // Journal of Luminescence. 2014. Т. 153. С. 417-420.

5. Саченко А.В., Беляев А.Е., Болтовец Н.С., Конакова Р.В., Капитанчук Л.М., Шеремет В.Н., Свешников Ю.Н., Пилипчук А.С. Механизм протекания тока в омическом контакте Au-Ti-Al-Ti-N+-GaN в интервале температур 4.2-300 К // Физика и техника полупроводников. 2014. Т. 48. № 10. С. 1344-1347.
6. Торхов Н.А., Божков В.Г., Свешников Ю.Н., Бабак Л.И., Добуш И.М., Коколов А.А., Сальников А.С., Новиков В.А. Влияние конструкции GaN/AlGaN-гетероструктур на приборные характеристики мощных НЕМТ Ka-диапазона // Известия высших учебных заведений. Физика. 2013. Т. 56. № 8-3. С. 124-127.